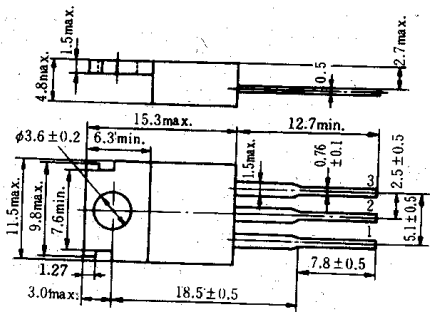
2SK296

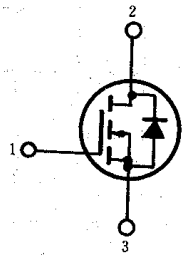
シリコン Nチャネル MOS FET
高速度電力スイッチング用

SILICON N-CHANNEL MOS FET
HIGH SPEED POWER SWITCHING



1. ゲート：Gate
2. ドレイン：Drain (フランジ)(Flange)
3. ソース：Source

(Dimensions in mm)



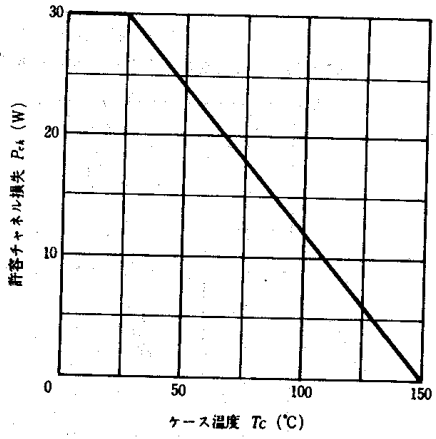
(JEDEC TO-220AB)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SK296	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	300	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	I_D	1	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(peak)}$	2	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	1	A
許容チャネル損失	P_{ch}*	30	W
チャネル温度	T_{ch}	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55〜+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容チャネル損失のケース温度による変化
MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	I_D=10mA, V_{GS}=0	300	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	V_{GS}=±20V, V_{DS}=0	—	—	±1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	V_{DS}=240V, V_{DS}=0	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	I_D=1mA, V_{DS}=10V	1.0	—	4.5	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	I_D=1A, V_{GS}=15V *	—	2.5	4.0	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$	I_D=1A, V_{GS}=15V *	—	2.5	4.0	V
順伝達アドミタンス	$\|y_{fs}\|$	I_D=0.5A, V_{DS}=10V *	0.2	0.4	—	S
入力容量	C_{iss}	V_{DS}=10V, V_{GS}=0 f=1MHz	—	140	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	65	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	23	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	I_D=0.5A, V_{GS}=15V R_L=60Ω	—	6	—	ns
立ち上がり時間	t_r		—	14	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	40	—	ns
下降時間	t_f		—	30	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	I_F=1A, V_{GS}=0	—	0.9	—	V
逆回復時間	t_{rr}	I_F=1A, V_{GS}=0, di_F/dt=100A/μs	—	250	—	ns

* パルス測定
* Pulse Test